PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-255519

(43) Date of publication of application: 11.09.2002

(51)Int.Cl.

C01B 31/02

(21)Application number : 2001-394105

(71) Applicant: TOYOTA CENTRAL RES & DEV

LAB INC

UNIV NAGOYA

(22)Date of filing:

26.12.2001

(72)Inventor: OKAMOTO ATSUHITO

SHINOHARA HISANORI

KAWAKUBO TOMOHISA

(30)Priority

Priority number : 2000400198

Priority date : 28.12.2000

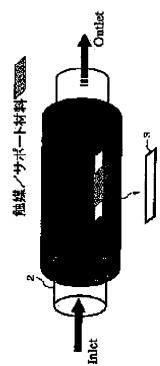
Priority country: JP

(54) PRODUCTION METHOD FOR MONOLAYER CARBON NANOTUBE AND REMOVAL METHOD OF ZEOLITE.

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the problem such that a synthetic method for a nanotube such as a laser deposition method and an arc discharge method is unsuitable for mass synthesis and caused much impurities such as an amorphous carbon, or the like, and at the same time, to improve the problem such that the catalyst metal stability in a synthetic temperature, the structure control of the catalyst particles and the particle size control at heating are subjects to be improved in thermal cracking method.

SOLUTION: This invention provides a production method for a monolayer carbon nanotube which is characterized by gas phase-synthesizing the monolayer carbon nanotube by the thermal cracking of a



hydrocarbon gas, by delivering the hydrocarbon gas together with a carrier gas onto a base substance which is obtained by dispersing and supporting catalyst particles to a heat resistant

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3743628

[Date of registration] 25.11.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公門番号 特開2002-255519 (P2002-255519A) (43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

(51) Int.CL.7

C01B 31/02

総別配号

101

FΙ

C 0 1 B 31/02

テーマコート*(参考) 101F 4G046

最終頁に続く

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全 10 頁)

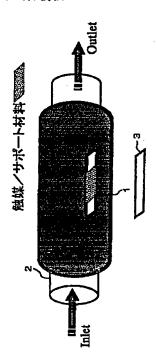
(21)出廢番号	特顏2001-394105(P2001-394105)	(71)出顧人	000003609 株式会社費田中央研究所
(22)出顧日	平成13年12月26日(2001.12.26)		愛知県愛知郡長久手町大字長数字横道41番 地の1
(31)優先権主張番号	特暦2000-400198 (P2000-400198)	(71)出額入	391012224
(32) 優先日	平成12年12月28日(2000.12.28)		名古量大学長
(33) 優先権主張国	日本 (JP)		受知県名古屋市千種区不老町(番地なし)
		(72)発明者	岡本 篤人
			愛知県愛知郡長久手町大字長湫字橫道41番
			地の1 株式会社豊田中央研究所内
		(74)代理人	100075258
			弁理士 吉田 研二 (外2名)
		(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 単層カーポンナノチューブの製造方法およびゼオライトの除去方法

(57)【要約】

【課題】 レーザ蒸着法およびアーク放電法などのカー ボンナノチューブの合成法は、大量合成に不向きである こと、アモルファスカーボン等の不純物が多いことなど の課題を有していた。一方、熱分解法では、合成温度に おける触媒金属の安定性、および触媒微粒子の構造制 御、加熱時の粒径制御が課題であった。

【解決手段】 本発明は、耐熱性の多孔性担体に触媒微 粒子を分散担持させた基体上に炭化水素ガスをキャリア ガスとともに送り、炭化水素ガスの熱分解を利用して、 単層カーボンナノチューブを気相合成することを特徴と する単層カーボンナノチューブの製造方法を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 耐熱性の多孔性担体に触媒微粒子を分散 担持させた基体上に炭化水素ガスをキャリアガスととも に送り、前記炭化水素ガスの熱分解を利用して、単層カ ーポンナノチューブを気相合成することを特徴とする単 層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項2】 前記多孔性担体の細孔径が3nm以下であ ることを特徴とする請求項1に記載の単層カーボンナノ チューブの製造方法。

【請求項3】 前記多孔性担体が、ゼオライト、シリカ 10 多孔体、または少なくとも1つの細孔を有する酸化物中 空殻構造体のいずれかであることを特徴とする請求項1 に記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項4】 前記ゼオライトは耐熱性を有することを 特徴とする請求項3に記載の単層カーボンナノチューブ の製造方法。

【請求項5】 前記ゼオライトは、SiO2 およびAl2 O3 を含み、

SiO₂ /Al₂ O₃ のモル比が 5以上であることを特徴とす る請求項4に記載の単層カーボンナノチューブの製造方 20

【請求項6】 前記ゼオライトは、SiO₂ およびAl₂ O₃ を含み、

SiO₂ /Al₂ O₃ のモル比が 1 O以上であることを特徴と する請求項4に記載の単層カーボンナノチューブの製造 方法。

【請求項7】 前記触媒微粒子が、前記多孔性担体の細 孔表面に担持されていること、および/または、前記多 孔性担体の細孔内に埋め込まれていることを特徴とする 請求項1万至6のいずれかに記載の単層カーボンナノチ 30 ューブの製造方法。

【請求項8】 前記触媒微粒子と前記多孔性担体とを含 tr溶液を攪拌した後、熱処理することによって、前記触 媒微粒子が、前記多孔性担体の細孔表面に担持されてい ること、および/または、前記多孔性担体の細孔内に埋 め込まれていることを特徴とする請求項?に記載の単層 カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項9】 前記溶液は、超音波振動によって攪拌さ れることを特徴とする請求項8に記載の単層カーボンナ ノチューブの製造方法。

【請求項10】 前記触媒微粒子と前記多孔性担体とを 超臨界流体中に含ませた後、熱処理することによって、 前記触媒微粒子が、前記多孔性担体の細孔表面に担持さ れていること、および/または、前記多孔性担体の細孔 内に埋め込まれていることを特徴とする請求項7に記載 の単層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項11】 前記炭化水素ガスの熱分解による単層 カーボンナノチューブの合成温度が、800℃以上である ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の 単層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項12】 前記多孔性担体は、前記触媒微粒子の 含有量が0.1-20wt%の範囲内であることを特徴とする請 求項1乃至11のいずれかに記載の単層カーボンナノチ ューブの製造方法。

【請求項13】 前記多孔性担体は、前記触媒微粒子の 含有量が0.2-5wt%の範囲内であることを特徴とする請 求項1乃至12のいずれかに記載の単層カーボンナノチ ューブの製造方法。

【請求項14】 前記単層カーボンナノチューブを製造 する合成反応管の容積はV ml、前記キャリアガスおよび 炭化水素ガスの流量はそれぞれ、x×V ml/min, Y×Bml/m inであり、前記x min , y min の範囲が、1/100≤x≤ 1. 1/1000≦v≦1/5であることを特徴とする請求項1乃 至13のいずれかに記載の単層カーボンナノチューブの 製造方法。

【請求項15】 前記キャリアガスおよび前記炭化水素 ガスの流量は、請求項14記載の範囲であり、

前記炭化水素ガスおよびキャリアガスが前記基体上に送 られて、熱分解される時間が約30分間であることを特徴 とする請求項14に記載の単層カーボンナノチューブの 製造方法。

【請求項16】 前記炭化水素ガスがアセチレンである ことを特徴とする請求項1乃至15のいずれかに記載の 単層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項17】 請求項1乃至16のいずれかの方法に より製造された直径1.2nm以下の単層カーボンナノチュ ープ。

【請求項18】 カーボンナノチューブの気相合成に用 いられる耐熱性多孔性担体の除去方法であって、前記カ ーポンナノチューブの気相合成後に、雰囲気圧を!Ter r、より望ましくは0.01Torr以下、かつ熱処理温度を140 0℃以上、より望ましくは2000℃以上にすることを特徴 とするカーボンナノチューブ合成用耐熱性多孔性担体の 除去方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カーボンナノチュ ープの製造方法に関する。特に本発明は、単層のカーボ ンナノチューブを製造する方法およびゼオライトの除去 40 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】炭素原子が筒状に並び、直径がナノメー トル単位の構造を有するカーボンナノチューブは、導電 性、電子放出能、ガス吸蔵特性などに優れた炭素系高機 能材料として非常に注目されている。カーボンナノチュ ープの製造方法としては、黒鉛等のアーク放電を用いる アーク放電法や、加熱した黒鉛にレーザを照射するレー ザ蒸発法などがある。

【0003】また、触媒を用いて炭化水素ガスを熱分解 50 することによりカーボンナノチューブを製造する熱分解

法(CVD法)も考案されている。熱分解法には、基体(S i基体やアルミナ粉末)上に触媒を塗布する方法と、触 媒を気相中に浮遊させる方法の2種類の方法が知られて いる。熱分解法に関しては、下記のような文献がある。

[0004] H. Daiらは、Chem. Phys. Lett. 260 (199 6) 471において、微粒子 (fumed) アルミナ粉末上にNo 化合物微粒子を担持してできた粉末を石英ボードに配置 して、1200℃で一酸化炭素ガスを1200sccm流して1時間 保持することによって単層チューブを得たことを報告し ている。

[0005] A.M. Cassel 6 tt., J. Phys. Chem. B 103 (1999) 6484において、アルミナ/シリカのハイブリッ ドサポート材料上にFe/Mo微粒子を担持してできた粉末 を石英ボードに配置して、900℃でメタンガスを6000cm /min流して2-45分間保持することによって単層チュー ブを得たことを報告している。

[0006] J.-F. Colomerらは、Chem. Phys. Lett. 3 17 (2000) 83において、酸化マグネシウム粉末上にCo、 Ni、Feもしくはその混合(Co/Fe)微粒子を担持してでき た粉末を石英ボードに配置して、1000℃でメタン/水素 混合ガスを75ml/min/300ml/min流して10分間保持するこ とによって単層チューブを得たことを報告している。

【0007】特許第3044280号には、多孔性無機 担体と該担体に担持された金属触媒上において、熱分解 促進剤の存在下で炭化水素を熱分解することで、合成温 度を低温化 (400-1000℃) して、カーボンナノチューブ (ただし、単層、多層は限定されていない) を合成でき ることが開示されている。

【0008】特開平11-11917号公報には、アル ミニウムの陽極酸化処理によってできた細孔(直径:5- 30 200nm) の底部に、触媒となるFe、CoおよびNiからなる 少なくとも一種の金属を形成して、プラズマCVD法によ ってカーボンナノチューブ(単層、多層は限定されてい ない)を合成できることが開示されている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】レーザ蒸着法およびア ーク放電法は、大量合成に不向きであること、アモルフ ァスカーボン等の不純物が多いことなどの課題を有して いた。また、レーザ蒸着法で合成される単層カーボンナ ノチューブの直径は、触媒金属の種類と組み合わせにも 40 よるが、1.2nm程度のものが多かった。

【0010】一方、熱分解法では、合成温度における触 媒金属の安定性、および触媒微粒子の構造制御、加熱時 の粒径制御が課題であった。すなわち、室温から合成温 度への昇温過程で触媒微粒子が凝集してしまい、それを 核として成長する単層チューブの合成が妨げられ、多層 チューブが合成されていた。

【0011】そこで本発明は、上記の課題を解決するこ とのできる単層カーボンナノチューブの製造方法を提供 することを目的とする。この目的は特許請求の範囲にお 50 -20wt%の範囲内であってもよい。また、望ましくは、

ける独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成され る。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定す

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、耐熱性 の多孔性担体に触媒微粒子を分散担持させた基体上に炭 化水素ガスをキャリアガスとともに送り、炭化水素ガス の熱分解を利用して、単層カーボンナノチューブを気相 合成することを特徴とする単層カーボンナノチューブの 10 製造方法が提供される。

【0013】これによって、室温、またはプレベーキン グで多孔性担体の細孔に分散担持された触媒が合成温度 においても安定に存在できるため、触媒の直径に応じた 細い単層チューブを合成することができる。

【0014】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、多孔性担体の細孔径は3mm以下であっても よい。また、多孔性担体はゼオライト、シリカ多孔体、 または少なくとも1つの細孔を有する酸化物中空殼構造 体であってもよい。ここで、シリカ多孔体は、たとえ 20 ば、MCM、FSMなどである。また、酸化物中空殼構造体 は、たとえば酸化アルミニウムからなる中空設構造体で

【0015】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、ゼオライトは耐熱性を有していてもよい。 また、ゼオライトは、SiOz およびAlz Oz を含み、SiO 2 /Al2 03 のモル比が5以上であってもよい。また、 望ましくは、ゼオライトは、SiOz およびAlz Os を含 み、SiO2 /Al2 O2 のモル比が10以上であってもよ ١\.

【0016】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、触媒微粒子は、多孔性担体の細孔表面に担 持されているか、多孔性担体の細孔内に埋め込まれてい るかの両方、またはいずれか一方であってもよい。触媒 微粒子の多孔性担体の細孔表面への担持、および/また は、多孔性担体の細孔内への埋め込みは、触媒微粒子と 多孔性担体とを含む溶液を攪拌した後、熱処理すること によって行われてもよい。この場合、触媒微粒子と多孔 性担体とを含む溶液の攪拌は、超音波振動によって行わ れてもよい。また、触媒微粒子の多孔性担体の細孔表面 への担持、および/または、多孔性担体の細孔内への埋 め込みは、触媒微粒子と多孔性担体とを超臨界流体中に 含ませた後、熱処理することによって行なわれてもよ W

【0017】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、炭化水素ガスの熱分解による単層カーボン ナノチューブの合成温度は、800℃以上であってもよ

【0018】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、多孔性担体は、触媒微粒子の含有量が0.1

多孔性担体は、触媒微粒子の含有量が0.2-5wt%の範囲 内であってもよい。

【0019】上記の単層カーボンナノチューブの製造方 法において、キャリアガスおよび炭化水素ガスの流量 は、x,yで規定される範囲(例えば、反応管の容積が600 Omlの場合、キャリアガスの流量が150ml/min、炭化水素 ガスの流量が10ml/minのとき、x=1/40 min ,y=1/600 m in である)であり、キャリアガスおよび炭化水素ガス が前記基体上に送られて、熱分解される時間が約30分間 であってもよい。また、上記炭化水素ガスはアセチレン 10 であってもよい。

【0020】また、別の発明は、カーボンナノチューブ の気相合成に用いられる耐熱性多孔性担体の除去方法で あって、前記カーボンナノチューブの気相合成後に、雰 囲気圧を1Torr、より望ましくは0.01Torr以下、かつ熱 処理温度を1400℃以上、より望ましくは2000℃以上にす

【0021】これによれば、酸に対して安定な耐熱性多 孔性担体を適切に除去することができる。

は、触媒微粒子が多孔性担体の細孔に均一に分散され、 しかも高温においても該多孔性担体の細孔に安定に保持 されるため、細孔径に準じた直径の単層カーボンを効率 的に製造することができる。さらに、本発明の製造方法 は、連続運転が可能であるので、カーポンナノチューブ を大量に合成することができる。

【0023】このように、本発明により直径の揃った単 層カーボンナノチューブを効率的に高純度にて製造する ことができるため、本発明によって合成された単層カー ポンナノチューブは、水素吸蔵材料、圧電池の電板材 料、電子放出素子材料、電気二重層キャパシター材料、 SPM (Scanning Probe Microscope) の探針等として好適 に利用することが可能である。

[0024]

【発明の実施の形態】 [実施形態1] 図1は、本発明の 実施形態1に係わる単層ナノチューブ (SWNT) 合成装置 の概略模式図である。合成装置は、加熱ヒーターと断熱 材からなる電気炉1、石英管2、ガス導入・排気系(図 示せず)、および触媒/サポート材料を載せるための石 英ボート3を備える。さらに図示されていないが、成長 40 なくとも1つの細孔を有する担体が好適に用いられる。 温度制御系、真空制御系、ガス流量計などが設置されて いる。

【0025】この装置を用いたカーボンナノチューブの 合成は以下のような手順で行われる。予め作製した触媒 /サポート材料粉末を石英ポートに載せ、電気炉1 (石 英管2) 中央に配置する。石英管2を密閉して、排気系 より所定の圧力(例えば、約10⁻⁵ Torr以上)まで減圧 し、その後、所望の雰囲気圧力となるように不活性なガ ス(Ar、N2等)によるガス置換と圧力調整をガス導入 流量と排気量制御によって行う。なお、プレベーキン

グ、非酸化雰囲気(たとえばAr、Hz、Nz またはそれら の混合ガス等)下で、例えば合成温度以下である600℃ に加熱し、30分保持する。引き続き、合成温度への昇温 を行い、合成温度に達した時点で、たとえば数分一数時 間キャリアガス(たとえばAr、H2、N2 またはそれらの 混合ガス等)と炭化水素ガスを適当な流量比で流しなが ら保持することで、カーボンナノチューブを高純度にて 合成することができる。

【0026】なお、上記手法で多層カーボンナノチュー ブが合成可能なことは、K. Mukhopadhyayらが、Chem. P hys. Lett. 303 (1999) 117に記載されている。K. Mukh opadhyayらは、600、700℃での合成例を紹介している。 本発明者らは、サポート材料、触媒、合成温度等を鋭意 検討し、『単層』カーボンナノチューブを炭化水素ガス の熱分解 (CVD) 法で合成するには、800℃以上の高温が 必要なことを突き止め、それに必要な各種成長条件を押 さえるに至った。

【0027】上記構成は、単層ナノチューブ合成温度に おいて熱的に安定に存在する多孔性担体を用いて、単層 【0022】 [発明の作用および効果] 本発明において 20 ナノチューブを合成することを特徴としている。これに よって、室温、またはプレベーキングで多孔性担体の細 孔に分散担持された触媒が合成温度においても安定に存 在できるため、触媒の直径に応じた細い単層チューブを 合成することができる。

> 【0028】なお、サポート材料としては、細孔径が3n m以下の多孔性担体が好適である。多孔性担体の好適な 具体例は、耐熱性のゼオライト、シリカ多孔体(FSM:Fol dedSheets Mesoporous Material)、中空設構造を有する 酸化アルミニウムなどである。これらの多孔性担体を使 20 用することで、これにより、多層チェーブや炭素不純物 が混入することなく、高純度で単層チューブを合成する ことが可能となる。

【0029】耐熟性のゼオライトとしては、SiOz /Al 20% 比が5以上、好適には、10以上のものが使用され る。また、用いられるゼオライトが粉末の場合、その平 均粒子径は0.1-100μmである。特に5-10μmのものが 好適に使用される。

【0030】中空殼構造を有する酸化アルミニウムとし ては、特に、エマルジョン燃焼法で得られるような、少 【0031】なお、多孔性担体としては、この他に、従 来公知のアルミナ、シリカ、マグネシア、ジルコニア、 チタニア、およびそれらのハイブリッド材料を使用する

【0032】また、触媒としては、主に酢酸塩等の錯体 である触媒金属化合物が挙げられるが、これに限定され るものではなく、既に公知の金属塩や金属触媒を用いて も同様な効果が得られる。また触媒として、Fe、Co等の 単元系触媒、Fe/Co、Ni/Co、Mo/Co、Ni/Fe等の二元系触 50 媒、または、Fe/Ni/Coの三元系触媒を用いることができ

ことができる。

(5)

る。なお、それぞれの触媒の担持量は、担体に対して、 0.1-20wt%が好ましく、より好ましくは、1-10wt%程度 である。これより少ないと単層チューブの収率が落ち、 またこれ以上だと、多層チューブ及び炭素不純物の生成 を催促させる恐れがある。

【0033】触媒は、触媒微粒子の形で、多孔性担体の 細孔表面/内部に担持されていることが望ましい。これ によって、細孔径に準じた直径の単層チューブを再現性 よく、しかも効率的に製造することが可能となる。触媒 微粒子を、多孔性担体の細孔表面/内部に担持する方法 10 としては、記触媒微粒子と多孔性担体とを含む溶液を攪 拌(溶液の攪拌には、超音波振動を用いてもよい) した 後、熱処理する方法がある。具体的には、触媒を、80℃ 以上で乾燥させた多孔性担体と一緒に純水、または/お よび有機溶媒に入れて攪拌含浸させ、乾燥させた後に、 微細粉末化して触媒に供せられる。ここで述べた方法と は別に、たとえば水晶基板や珪素基板表面に多孔性担体 **薄膜(たとえばゼオライト薄膜)を直接成膜し、純水、** または/および有機溶媒中に触媒を分散させた溶液を、 例えばスピナー塗布して、その後、80℃以上で乾燥させ 20 た基板を触媒に供することも可能である。

【0034】また、触媒微粒子を、多孔性担体の細孔表 面/内部に担持する方法としては、触媒微粒子と多孔性 担体とを超臨界流体中に含ませた後、熱処理する方法な どがある。超臨界流体は、臨界温度及び臨界圧力を越え た温度、圧力下で、ガスの密度が急激に上昇して気体と も液体ともつかぬ流体状態となっているものを指す。応 用例としては、コーヒーやたばこから、カフェイン、ニ コチンを除去するなどの超臨界抽出を挙げることができ る。また超臨界流体は、液体と同等の溶解能力と、気体 30 に近い高拡散性、低粘性を有する物質であり、さらに表 面張力の欠如はミクロンオーダーより小さい微細孔内ま で容易に反応前駆体を運搬する役目を果たす。具体的に は、金属アセテートなどの金属錯体(反応前駆体)を、 二酸化酸素などの超臨界流体中に溶解した。溶解度は温 度、圧力、エントレーナー(添加物)により調整可能で ある。上記超臨界流体としては、例えば、二酸化炭素以 外に、メタン、エタン、エチレン、プロパン、ブタン、 メタノール、エタノール、アセトンなどがある。またエ ントレーナーとしては、キシレン、トルエンなどを挙げ 40 ることが出来る。超臨界二酸化酸素を利用する場合、臨 界点 (臨界温度:31.0℃、臨界圧力:72.9気圧) 以上の 条件、例えば、35-300℃、75-350気圧にて、上記金属 錯体を孔の中に浸透させる。その後、常温常圧に戻し て、超臨界流体をガス化して除去したのち、真空中、あ るいは、Ar、N2 などの非酸化雰囲気中において100-60 0℃程度の温度で熱処理を行うことで、金属触媒が多孔 体に担持することができる。

【0035】合成に用いる炭化水素ガスの好適な例は、 アセチレンである。アセチレンを用いることで、高純度 50 で単層チューブを合成することが可能となる。なお、炭化水素ガスとしては、この他、公知のメタン、エチレン、一酸化炭素、ベンゼンなどを使用することができる。

【0036】以上説明した、本発明の単層カーボンナノチューブの製造方法を用いると、直径が比較的細い(1.2nm以下)カーボンナノチューブを得ることができる。得られたカーボンナノチューブは、直径が小さいことかち、電子放出素子のエミッタ材料等として好適に使用できる。

【0037】以下に実施形態2~6として、より具体的な作成手順と得られたカーボンナノチューブの特性について説明する。

【0038】 [実施形態2] 耐熱性Y型ゼオライト粉末 (東ソー製; HSZ-390HUA, SiO₂ /Al₂O₃ モル比: 200) に、 触媒金属化合物 (Iron(II) Acetate、Cobalt(II) Aceta te Tetratydrate) を用いて、Fe/Co触媒をゼオライト細 孔に担持した。触媒の含有量は、それぞれ2.5wt%で実施 した。その後、石英ポートに触媒粉末を配置し、プレベ ーキングを600℃、30分、Ar雰囲気1気圧(Ar流量:120m 1/min) にて行った。その後、合成温度3水準 (800℃、8 50℃、900℃)にて昇温し、Ar/C2 H2 雰囲気I気圧(Ar/C 2 H2 流量:150ml/min/10ml/min)で30分熱処理を行っ た。熱処理後、合成物を透過電子顕微鏡(TEM)で観察 したところ、全ての合成温度条件で、単層チューブのバ ンドル(束)が観察された。一例として900℃での合成 の結果を図2に示す。それらが単層チューブのバンドル であることを明確に示す写真を図3に示した。写真に は、バンドルの断面構造が明確に現れている。なお、合 成涅度が上がるほど、単層チェーブの収率が増加した。 こうして得られたカーボンナノチューブの水素吸蔵特性 を評価した結果、5-10wt%の水素吸蔵能を有することが 判明した。

【0039】 [実施形態3] 耐熱性Y型ゼオライト粉末 (東ソー製; HSZ-390HUA、Si02 /Al2 03 モル比: 200) に、触媒金属化合物 (Iron(II) Acetate、Cobalt(II) Acetate Tetratydrate) を用いて、Fe/Co触媒をゼオライト細孔に担持した。触媒の含有量は、それぞれ0.5wt%で実施した。その後、石英ボートに触媒粉末を配置し、プレベーキングを600℃、30分、Ar雰囲気1気圧 (Ar流量: 120ml/min) にて行った。その後、合成温度3水準(800℃、850℃、900℃) にて昇温し、Ar/C2 H2 雰囲気1気圧(Ar/C2 H2 流量: 150ml/min/10ml/min)で30分熱処理を行った。熱処理後、合成物を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したところ、全ての合成温度条件で、単層チューブのバンドル(東)が観察された。一例として900℃での合成の結果を図4に示す。単層チューブのバンドルのみが生成し、多層チューブはほとんど観察されなかった。

【0040】なお、触媒の含有量を下げることで単層・

多層両チューブを合わせた収率は下がるが、そのうち単層チューブが得られる収率は増加した。図5は、触媒の含有量に対する単層チューブの収率依存性を示すグラフである。触媒の含有量は0.1-20wt%の範囲が好ましく、特に、触媒の含有量は0.2-5wt%の範囲がより好ましい。触媒の含有量が0.2-5wt%の範囲のとき、単層チューブの収率がより高くなった。こうして得られたカーボンナノチューブの水素吸蔵特性を評価した結果、5-10wt%の水素吸蔵能を有することが判明した。

【0041】 [実施形態4] 耐熱性Y型ゼオライト粉末 (東ソ一製; HSZ-390HUA、SiO2 /A12 O3 モル比: 200) に、触媒金属化合物 (Iron(II) Acetate、Cobalt(II) Acetate Tetratydrate) を用いて、Fe/Co触媒をゼオライト細孔に担持した。触媒の含有量は、それぞれ0.5 wt%で実施した。その後、石英ボートに触媒粉末を配置し、プレベーキングを600℃、30分、Ar雰囲気1気圧(Ar流量: 120ml/min)にて行った。その後、合成温度2水準(600℃,900℃) にて昇温し、Ar/C2 H2 雰囲気1気圧(Ar/C2 H2 流量: 150ml/min/10ml/min)で熱処理時間(10分,30分,60分)を変えて収率を計測した。

【0042】図6は、熱処理時間(合成時間)と収率(ゼオライト粉末(触媒を含む)の仕込み重量に対する合成物重量(前記合成物重量を除く)の重量比)の関係(合成温度600℃,900℃)を示すグラフである。また、図7は、熱処理時間(合成時間)と相対収量(各合成時間における収量を合成時間60分における収量を基準として数値化)の関係(合成温度600℃,900℃)を示すグラフである。このように、たとえば、合成温度900℃では、合成時間30分で相対収量は95%以上であり、合成時間が約30分で合成がほぼ完了していることがわかる。

【0043】 [実施形態5] FSM粉末 (発明者により作製: 細孔径2-3nm) にFe/Co触媒を担持した。 触媒の含有量は、それぞれ2.5wt%で実施した。その後、石英ボートに触媒粉末を配置し、プレペーキングを600℃、30分、Ar雰囲気1気圧 (ArまたはNz 流量:120ml/min) にて行った。その後、合成温度3水準 (800℃、850℃、900℃) に昇温し、Ar/Cz Hz 雰囲気1気圧 (Ar/Cz Hz 流量:150ml/min/10ml/min) で30分熱処理を行った。熱処理後、合成物を透過電子顕微鏡 (TEM) で観察したところ、全ての合成温度条件で、単層チューブのバンドル (束) が観 40察された。一例として900℃での合成の結果を図8に示す。こうして得られたカーボンナノチューブの水素吸蔵特性を評価した結果、5-10wt%の水素吸蔵能を有することが判明した。

【0044】 [実施形態6] 中空殼構造酸化アルミニウム粉末 (発明者により作製:細孔径2-3nm) にFe/Co触媒を担持した。触媒の含有量は、それぞれ2.5wt%で実施した。その後、石英ボートに触媒粉末を配置し、プレベーキングを600℃、30分、Ar雰囲気1気圧 (ArまたはN₂流量:120m1/min) にて行った。その後、合成温度3水準 (8 50

00℃、850℃、900℃)にて昇温して、30分、Ar/C2 H2 雰囲気1気圧(Ar/C2 H2 流量:150ml/min/10ml/min)で熱処理を行った。熱処理後、合成物を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したところ、全ての合成温度条件で、単層チューブのバンドル(束)が観察された。こうして得られたカーボンナノチューブの水素吸蔵特性を評価した結果、5-10wt%の水素吸蔵能を有することが判明した。【0045】以上、本発明の単層カーボンナノチューブの製造方法に従ってカーボンナノチューブを作成した例を説明した。次に、本発明の効果を検証するための比較例を示す。

【0046】 [比較例1] 耐熱性Y型ゼオライト粉末 (東ソー製:HSZ-390HUA)に、触媒金属化合物(Iron(I I) Acetate, Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate) を用い て、Fe/Co触媒を該ゼオライト細孔に担持した。触媒の 含有量は、それぞれ20wt%で実施した。その後、石英ボ ードに触媒粉末を配置し、プレベーキングを600℃,30 分, Ar雰囲気1気圧 (Ar流量: 120ml/min) にて行った。 その後、合成温度3水準 (800℃, 850℃, 900℃) にて昇 20 温して、30分, Ar/C-H-雰囲気1気圧(Ar/C-H-流量:150 ml/min/10ml/min) で熱処理を行なった。熱処理後、合 成物を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したところ、全て の合成温度条件で、主に多層チューブのバンドルが観察 された。一例として、900℃での合成の結果を図9に示 した。この写真から多層チューブが生成している様子が わかる。別視野の観察から僅かであるが単層チューブも 観察された。含有量を上げることで単層・多層両チュー ブを合わせた収率は上がるが、そのうち単層チューブが 得られる収率は減少した。単層チューブの収率依存性は ・同様に図6に示したとおりである。

【0047】[比較例2]多孔性担体としてY型ゼオラ イト粉末(東ソー製:HSZ-320NAA)を用い、Y型ゼオラ イト粉末にFe/Co触媒を担持した。その後、石英ボート に触媒粉末を配置し、プレベーキングを600℃、30分、A r雰囲気1気圧(ArまたはN2 流量:120ml/min)にて行っ た。その後、合成温度3水準:600℃、700℃、900℃に昇 温して、30分、Ar/C2 H2 雰囲気1気圧(Ar/C2 H2 流量: 100ml/min/15ml/min)で熱処理を行った。熱処理後、合 成物を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したところ、全て の合成温度条件で、多層チューブが観察された。一例と して700℃での合成の結果を図10に示す。この場合、9 00℃でも単層カーボンナノチューブは確認されなかっ た。なお、多層チューブの収率、結晶性は、温度が低い ほど良い傾向を示した。このように、単層カーボンナノ チューブを得るためには、本発明の構成要件である耐熱 性の高い多孔性担体を用いることが重要であることが明 らかである。

【0048】次に、カーボンナノチューブ合成に用いた 耐熱性ゼオライトの除去を可能とする実施形態を説明す

【0049】 [実施形態7] 耐熱性多孔性担体として耐 熱性ゼオライトを用いた場合には、単層チューブ合成ま たは多層チュープ合成いずれのケースであっても、合成 後の耐熱性ゼオライト粉末は、雰囲気圧0.01Torr,2000 ℃で熱処理することにより除去された。図11は、熱処 理による耐熱性ゼオライトの除去を行った後のカーボン ナノチューブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像である。カ ーポンナノチューブだけが撮像され、耐熱性ゼオライト が除去されていることが分かる。耐熱性ゼオライト粉末 が、上記熱処理により除去が可能である。

[0050]

【発明の効果】上記説明から明らかなように、本発明に よれば、単層カーボンを効率的に製造することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態1に係わる単層ナノチュー ブ (SWNT) 合成装置の概略模式図である。

【図2】 本発明の実施形態2の製造方法によって合成 された単層カーボンナノチューブのバンドル(束)の透 20 った後のカーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡(TE 過型電子顕微鏡 (TEM) 像を示す図である。

【図3】 本発明の実施形態2の製造方法によって合成 された単層カーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像を示す図である。

*【図4】 本発明の実施形態3の製造方法によって合成 された単層カーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像を示す図である。

12

【図5】 触媒の含有量に対する単層チューブの収率依 存性を示すグラフである。

【図6】 熱処理時間と収率の関係(合成温度600℃,9 **00℃**) を示すグラフである。

【図7】 熱処理時間と相対収量の関係(合成温度600 ℃,900℃)を示すグラフである。

は、酸に対して安定であり、酸による除去は困難である 10 【図8】 本発明の実施形態5の製造方法によって合成 された単層カーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像を示す図である。

> 【図9】 比較例1の製造方法によって合成されたカー ボンナノチューブの透過型電子顕微鏡(TEM)像を示す 図である。

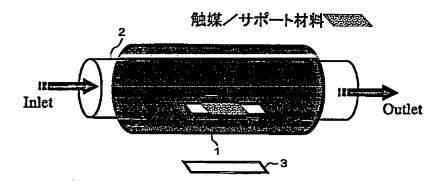
> 【図10】 比較例2の製造方法によって合成されたカ ーポンナノチューブの透過型電子顕微鏡 (TEM) 像を示 す図である。

> 【図11】 熱処理による耐熱性ゼオライトの除去を行 M) 像である。

【符号の説明】

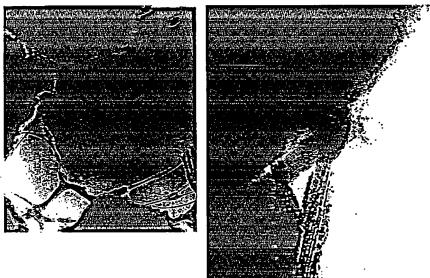
1 電気炉、2 石英管、3 石英ポート。

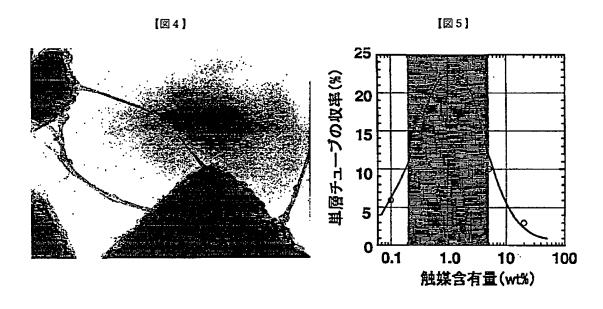
【図1】

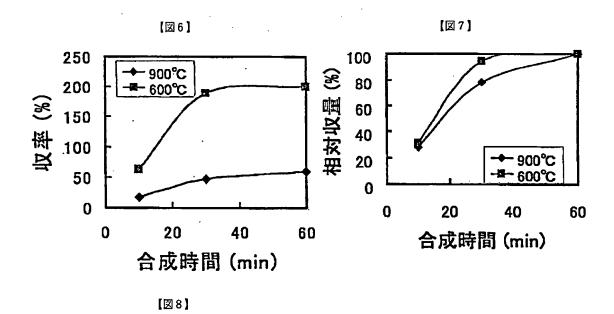


11

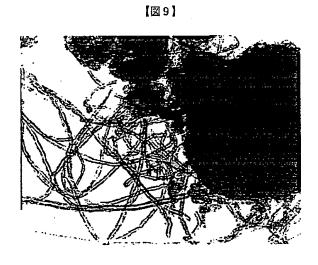




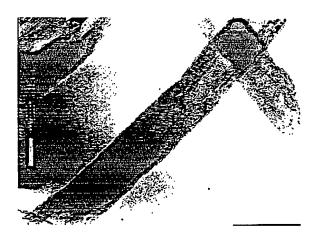




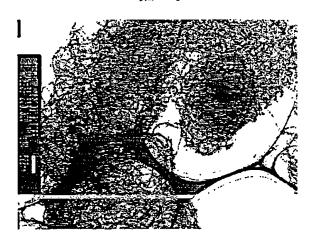




[図10]



【図11】



フロントページの続き

(72) 発明者 篠原 久典 愛知県名古屋市天白区植田本町 3 丁目917 (72) 発明者 川窪 智壽 愛知県名古屋市昭和区川名本町2-9-2 メゾン・ド・ソヌール207号Fターム(参考) 46046 CA02 CB03 CC06 CC08

Featured Front Line of Preparation and Application of Nano Carbon Material

Synthesis of high-purity Carbon Nanotubes using Zeolite CCVD

<Introduction>

A carbon nanotube is prepared through arch discharge, laser vaporation, chemical vapor deposition (CVD), or the like. We had developed a CVD which is suitable for mass production of carbon nanotubes because during the sysenthesis process, relatively less carbon impurities, such as an amorphous carbon, are formed and the scale of the carbon nanotube can be easily increased. The CVD synthesis of carbon nanotubes using micropores at the surface of zeolite will be introduced herein.

<Catalyst Chemical Vapor Deposition (CCVD)>

A catalyst-supported chemical vapor deposition (CCVD) is a synthesis method in which a hydrocarbon-based gas which acts as a carbon source is provided to a transition metal or alloy thereof acting as a catalyst which is maintained at a proper temperature, such as 1000°C or lower. According to a conventional thermal CVD method, a catalyst metal aggregates duiring processes, for example, during a temperature-increase process to a synthesis temperature, and thus, the synthesized tube has non-uniformed diameters or crystallinity.

We found that production of a carbon nanotube could be controlled by immersing a metal catalyst in surface micropores of a microporous material. In addition, we also found that during the immersing of a metal catalyst, the kind or size

of a catalyst, a synthesis temperature, and the kind or flow of a <u>used</u> gas determine the kind of a carbon nanotube to be synthesized (MWNT, DWNT, SWNT), or the yield and diameter of the carbon nanotube.

The required device is very simple so that any one can do this experiment using a commertial tube furnace. For reference, a schemical structure of the device we use is illustrated in FIG. 1. In the experiment, an acetic acid salt, such as iron acetate or cobalt acetate, and zeoliate acting as a porous material are dissolved in a solvent, such as alcohol or water, and then dried in an oven. The resultant powder mixture is loaded onto a quartz boat, the boat is moved to the center of a reactor, and then the systhesis is started under desried conditions.

<Synthesis of High Purity Carbon Nonotube>

Multi-walled Carbon Nanotubes (MWNTs) and Two-walled Carbon Nanotubes

(DWNTs)

Hernadi et al. first carried out a CVD synthesis in which a porous material is used as a template to support a metal catalyst, and we, based on the CVD synthesis, has developed a unique device and performed this experiment using zeolite as a template for a metal medium under various growth conditions. As a result, we succeed to synthesize high-purity MWNTs (FIG. 2). In addition, we found proper medium, kind of a porous material (Fe-Co, HSZ-320NAA (tosoh)), and synthesis temperature (1000°C or less), so that MWNTs having relatively uniform diameters of 10 nm to 30 nm coud be obtained. Furthermore, DWNTs having diameters of 1.5 – 2

nm having high quality were obtained by using a heat-resisting zeolite.

Single-walled Carbon Nanotubes (SWNTs)

A method of synthesizing SWNTs according to CCVD is similar to that of MWNTs. However, when SWNTs are synthesized, it is important to maintain the size of a metal catalyst acting as a growth seed of SWNTs to a few or less nanometers. The maintaining of the size of a metal catalyst to a few or less nanometers is an important factor for the growth. Accordingly, we focused on stability of a porous material at high temperature and the diameter of micropores of the surface of the porous material. A porous material most suitable for the synthesis of SWNTs we found was a Y type high silia zeolite(HSZ-390HUA(tosoh)). The synthesis results are shown in FIG. 3. Referring to FIG. 3, the bundle diameter was about 8.3 nm and thus it is assumed that there are 30 or more of single-layered carbon nanotubes. In addition, there were many bundles, which indicates the synthesized SWNTs has high purity.

In addition, when alcohols are used with the reaction gas, purity of SWNTs can be increased.

FIG. 4 shows the analysis results of Raman scattering spectroscopy of a synthesis medium including a bundle of SWNTs. The spectrum of low wave numbers is called as a radial breathing mode (RBM) SWNTs at a vibration mode corresponding to the diameter of SWNTs (vibration mode in the direction of the central axis of the tube). As the vibration number is inversely proportionally to the diameter, it can be assumed that the diameter of formed SWNTs decrease as the synthesis

temperature decrease. Such a result is the same as when SWNTs synthesized using a laser ablation method is used.

As a result, it is apparaent that since the diameter of synthesized a few SWNTs is equal to the diameter of the porous material, the diameter of SWNTs is controlled by adjusting the micropore diameter of the porous material. That is, the surface micropore of the porous material supporting the metal catalyst acts as a growth point when SWNTs are formed.

<Conclusion>

It is apparent that according to the CCVD, high-purity multi-walled and single-walled carbon nanotubes are synthesized with excellent controlabilty. When a carbon nanotube is used as an electrode device and as a high-functional material due to chemical surface modification, SWNT must have factors of ① high-puirty synthesis, ② single diameter control, and ③ chirality (spiral structure). When these factors are obtained, properties and electrical properties of SWNTs can be highly reliably evaluated, and at the same time, SWNTs can be commertially used.